SIMD 编程实验──以高斯消去为例

杜忱莹 2021 年 4 月 安祺 2022 年 3 月

目录

1	实验介绍			
	1.1	实验选	题	3
	1.2	实验要	· 求	3
		1.2.1	默认选题基本要求(最高获得 80% 分数)	3
		1.2.2	默认选题进阶要求(最高可获得剩余 20% 分数)	3
		1.2.3	自主选题	4
		1.2.4	实验报告	4
2	实验	设计指导	류	4
	2.1	普通高	斯消去算法	4
		2.1.1	算法分析	4
		2.1.2	算法设计与编程	5
		2.1.3	NEON 的 C/C++ 编程	10
		2.1.4	SSE/AVX 的 C/C++ 编程	12
3	程序编译及运行			13
4	使用	VTun	e 等工具剖析程序性能	14

1 实验介绍

1.1 实验选题

- 1. 默认选题: 高斯消去法的 SIMD 并行化。
- 2. 鼓励自主选题,与期末研究报告结合:在期末研究报告大的研究课题中,选取适合的子问题(如某步关键运算)进行 SIMD 并行实验,这部分工作未来可作为期末研究报告的一部分。
- 3. 自选题目难度至少与默认选题相当,且适合 SIMD 并行化。期末研究报告是两人小组合作方式的话,本次作业可独立完成、也可小组合作完成。无论选择哪种方式,总工作量应是单人的两倍,且两人应完成不同工作内容——即对期末研究报告的两个子问题分别进行 SIMD 并行化、而不能是"编程、实验、撰写报告"这样的分工。选择小组合作方式的话,在实验报告中应描述清楚两人的分工。
- 4. 自主选题应在研究报告中首先简要描述期末研究报告的选题大方向, 然后详细描述本次 SIMD 编程实验的选题,接下来才是算法设计、实 现、实验和结果分析等内容。

1.2 实验要求

1.2.1 默认选题基本要求(最高获得 80% 分数)

ARM 平台上普通高斯消去计算的基础 SIMD 并行化实验,包括设计 Neon 算法、编程实现、进行实验,讨论一些基本的算法/编程策略对性能的 影响,如对齐与不对齐、选择对串行算法的不同部分(4-6 行除法、8-13 行消去)进行向量化等,实验中应测试不同问题规模下串行算法/并行算法的性能、不同算法/编程策略对性能的影响等。

1.2.2 默认选题进阶要求(最高可获得剩余 20% 分数)

除普通高斯消去外,还对一种特殊的高斯消去计算进行 SIMD 并行化实验,在其中还可探讨不同平台(如 x86)、不同指令集(SSE、AVX、AVX-512等)以及体系结构相关优化(如 cache 优化)等实验。

1.2.3 自主选题

自主选题视难度和工作量与默认题目对等评分。

1.2.4 实验报告

撰写研究报告(问题描述(特别是对自主选题,首先简要描述期末研究报告的大问题,然后具体描述本次 SIMD 编程实验涉及的子问题)、SIMD 算法设计(最好有复杂性分析)与实现、实验及结果分析),符合科技论文写作规范,附 Git 项目链接。

2 实验设计指导

2.1 普通高斯消去算法

2.1.1 算法分析

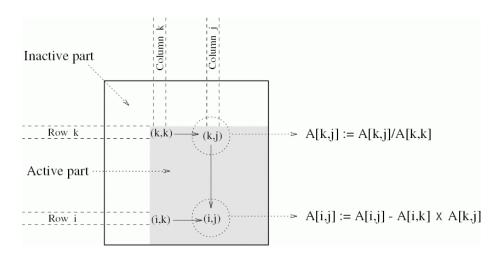


图 2.1: 高斯消去法示意图

高斯消去的计算模式如图2.1.1所示,在第 k 步时,对第 k 行从 (k,k) 开始进行除法操作,并且将后续的 k+1 至 N 行进行减去第 k 行的操作,串行算法如下面伪代码所示。

```
procedure LU (A)
begin
for k := 1 to n do
```

```
4
        for j := k+1 to n do
 5
          A[k, j] := A[k, j]/A[k, k];
 7
        A[k, k] := 1.0;
 8
         for i := k + 1 to n do
 9
         for j := k + 1 to n do
10
            A[i, j] := A[i, j] - A[i, k] \times A[k, j];
11
            endfor;
        A[i, k] := 0;
12
          endfor;
13
14
        endfor;
    end LU
```

观察高斯消去算法,注意到伪代码第 4, 5 行第一个内嵌循环中的 A[k,j] := A[k,j]/A[k,k] 以及伪代码第 8, 9, 10 行双层 for 循环中的 $A[i,j] := A[i,j] - A[i,k] \times A[k,j]$ 都是可以进行向量化的循环。可以通过 SIMD 扩展指令对这两步进行并行优化。

2.1.2 算法设计与编程

下面给出一个使用 SIMD Intrinsic 函数对普通高斯消元进行向量化的 伪代码,见算法1,同学们基本上可以逐句翻译为 Neon/SSE/AVX(-512)高 斯消元函数,完成 ARM 和 X86 平台的基本实验(当然要补齐测试样例生成、时间测量等辅助程序)。篇幅所限,这里只给出了 4 路向量化的算法,对 AVX/AVX-512,同学们需将其改为 8 路/16 路向量化算法。此外,这里只给出了支持内存不对齐的 SIMD 访存操作。注意,在 x86 平台上还要考虑是否使用了支持内存不对齐的访存指令,使用内存对齐的访存指令需要 对起始下标进行调整。

在设计算法时,我们需要注意以下要点:

1. 测试用例的确定。

对本题而言,运行时间与问题规模的变化趋势不是关注重点,但是测试规模较小时,可能会出现并行算法比串行算法还要耗时的情况。此外,类似之前的作业,我们同样可以考虑 cache 大小等系统参数来设计实验中的不同问题规模。

此外,方便起见,可以人为选取一段不会出现运算错误的测试用例,否则计算结果可能会出现 Naf 或无穷,可参考如下代码。

Listing 1: 测试用例生成

Algorithm 1: SIMD Intrinsic 版本的普通高斯消元

```
Data: 系数矩阵 A[n,n]
   Result: 上三角矩阵 A[n,n]
1 for k = 0 to n-1 do
      vt \leftarrow dupTo4Float(A[k,k]);
      for j = k + 1; j + 4 \le n; j + = 4 do
3
          va ← load4FloatFrom(&A[k,j]); // 将四个单精度浮点数从
 4
           内存加载到向量寄存器
          va \leftarrow va/vt;
                                               // 这里是向量对位相除
 \mathbf{5}
          store4FloatTo(&A[k,j],va); // 将四个单精度浮点数从向量
 6
           寄存器存储到内存
      for j in 剩余所有下标 do
7
       A[k,j]=A[k,j]/A[k,k]; // 该行结尾处有几个元素还未计算
 8
      A[k,k] \leftarrow 1.0;
9
      for i \leftarrow k+1 to n-1 do
10
          vaik \leftarrow dupToVector4(A[i,k]);
11
          for j = k + 1; j + 4 \le n; j + = 4 do
12
             vakj \leftarrow load4FloatFrom(&A[k,j]);
13
             vaij \leftarrow load4FloatFrom(&A[i,j]);
14
             vx \leftarrow vakj^*vaik;
15
             vaij \leftarrow vaij-vx;
16
             store4FloatTo(&A[i,j],vaij);
17
          for j in 剩余所有下标 do
18
           \label{eq:alpha} \left| \quad A[i,j] \leftarrow A[i,j] - A[k,j]^* A[i,k]; \right.
19
          A[i,k] \leftarrow 0;
20
```

```
float m[N][N];
 1
    void m_reset()
 2
 4
         for(int i=0;i< N;i++)
 5
 6
             for(int j=0; j< i; j++)
 7
                m[i][j]=0;
 8
             m[i][i]=1.0;
             for(int j=i+1; j< N; j++)
 9
10
                m[i][j]=rand();
11
12
         for(int k=0;k< N;k++)
13
             for(int i=k+1; i< N; i++)
14
                for(int j=0; j<N; j++)
15
                    m[i][j]+=m[k][j];
16
```

- 2. 设计对齐与不对齐算法策略时,注意到高斯消去计算过程中,第 k 步消去的起始元素 k 是变化的,从而导致距 16 字节边界的偏移是变化的。对于 ARM 平台的实验,在 AArch64 NEON 访存指令默认支持未对齐内存访问;在 NEON 汇编代码中可以指定对齐比特位数,这里可以进一步探究对齐 NEON 指令与未对齐性能差异,更多信息可参考官方手册对应内容(超链接):
 - 《NEON Programmer's Guide》中关于内存对齐访存指令语法和性能 影响的说明

对于 x86 平台的实验,如果设计不对齐的算法策略,直接使用 $_{\rm mm_loadu_ps}$ 即可。如果设计对齐算法使用 $_{\rm mm_load_ps}$ 时,我们可以调整算法,先串行处理到对齐边界,然后进行 SIMD 的计算。可对比两种方法的性能。 C++ 中数组的初始地址一般为 16 字节对齐,所以只要确保每次加载数据 A[i:i+3] 中 i 为 4 的倍数即可,大家如果不确定地址是否对齐,可以直接将地址打印出来对比。同理当进行 AVX 算法设计时应该注意是否 32 字节对齐问题。还可查阅资料,不同平台和编译器下一般都有指定对齐方式的动态内存分配函数,可采用这种方式确保分配的内存起始地址是对齐的。

例如 c11 标准中可以使用 aligned_alloc 进行对齐内存分配。

```
1 //函数原型
void *aligned_alloc( size_t alignment, size_t size );
3 4 //例子
```

```
5  int *p2 = aligned_alloc(1024, 1024*sizeof *p2);
6  printf("1024—byte_aligned_addr:u%p\n", (void*)p2);
7  free (p2);
```

3. 对不同部分的优化可进行对比实验。

高斯消去法中有两个部分可以进行向量化,我们可以对比一下这两个部分(一个二重循环、一个三重循环)进行 SSE 优化对程序速度的影响。

4. 并行计算结果的误差处理。

并行计算由于重排了指令执行顺序,加上计算机表示浮点数是有误差的,可能导致即使数学上看是完全等价的,但并行计算结果与串行计算结果不一致。这不是算法问题,而是计算机表示、计算浮点数的误差导致,一种策略是允许一定误差,比如 < 10e⁻⁶ 就行;另外一种策略,可在程序中加入一些数学上的处理,在运算过程中进行调整,来减小误差。我们用以下两个程序来展示。

(1) 两个数相除再相乘:

```
1
      float a = 1.0;
2
      float b = 3.0;
     for (int i = 0; i < N; i++)
3
     {
5
       a /= b;
6
7
      for (int i = 0; i < N; i++)
8
9
       a *= b;
10
11
     cout << a << endl;
```

当 N 大于一定值时输出的 a 不为 1:

```
1
2
  N为77结果: 1
3
  N为78结果: 1
   N为79结果: 1
4
  N为80结果: 1
   N为81结果: 1
  N为82结果: 0.999999
   N为83结果: 0.999997
9
   N为84结果: 0.999998
10
  N为85结果: 0.99998
11 N为86结果: 1.00003
12 N为87结果: 1.00018
13 N为88结果: 1.00018
```

14 .

(2) N 个数求和

```
const int NUM = 2048;
 2
      const int LOGN = 12;
 3
 4
      double elem[6][NUM], sum, sum1, sum2;
      void init (double e[][NUM], int m)
 5
 6
          for (int i = 0; i < NUM; i++)
 7
 8
 9
               e[m][i] = (rand() \% 10) / 7.0;
10
11
12
13
      void chain(int m, int n)
14
15
          sum = 0;
16
          for (int i = 0; i < n; i++) {
17
               sum += elem[m][i];
18
19
20
      void tree(int m, int n)
21
22
          int i, j;
23
24
          while (n >= 8) {
25
               for (i = 0, j = 0; i < n; i += 8) {
                   elem[m][j] = elem[m][i] + elem[m][i + 1];
26
27
                   elem[m][j + 1] = elem[m][i + 2] + elem[m][i + 3];
28
                   elem[m][j + 2] = elem[m][i + 4] + elem[m][i + 5];
29
                   elem[m][j + 3] = elem[m][i + 6] + elem[m][i + 7];
                   j += 4;
30
31
32
              n>>=1;
33
34
35
          \mathsf{elem}[\mathsf{m}][\mathsf{0}] \mathrel{+}= \mathsf{elem}[\mathsf{m}][\mathsf{1}];
36
          elem[m][2] += elem[m][3];
37
          \mathsf{elem}[\mathsf{m}][\mathsf{0}] \mathrel{+}= \mathsf{elem}[\mathsf{m}][\mathsf{2}];
38
```

运行 chain 以及 tree 函数,由于这两个函数的求和顺序不一致,结果可能不一样。这里最终的一次结果为:

```
Tree: 1301.14285714285688300151
```

Chain: 1301.14285714285460926476

5. 更多探索。

同学们如有余力,可探索更多的算法策略、程序优化方法,如循环展开、cache 优化等等。自主选题的同学不要局限于例子中循环展开、打包向量化的思路,可根据选题的特点选择恰当的 SIMD 指令进行并行优化。

2.1.3 NEON 的 C/C++ 编程

这里主要围绕 Neon Intrinsic 进行说明,如果希望进行更细粒度的编程可以考虑在源程序直接内嵌汇编代码。

使用 NEON intrinsic 需要包含的头文件如下

1 #include <arm_neon.h>

编译选项: -march=native 或-march=armv8-a

一些常用的指令:

```
//数据类型
 1
    float32\_t,, float32\times4\_t, float64\times2\_t, float32\times4\times2\_t...
    int8\_t, int8\times16\_t, int16\times8\_t, int32\times4\_t, int64\times2\_t, int8\times16\times2\_t...
 3
 4
    //load: 以float为例
 5
 6
   | float32x2_t vld1_f32(float32_t const *ptr); //读取连续2个单精度浮点数到向量寄存器
 7
    float32×4_t vld1q_f32(float32_t const *ptr); /读取连续4个单精度浮点数到向量寄存器
    float32x4x2_t vld2q_f32(float32_t const *ptr); //读取连续8个单精度浮点数到2个向量寄存器
 8
10
    //store:
    void vst1q_s32(int32_t * ptr, int32x4_t val); //将向量元素保存为连续4个32位整数数
11
    void vst1q_u32(uint32_t * ptr, uint32x4_t val);
12
13
    //将向量元素保存为连续4个32位无符号整数数
14
    void vst1q_f32(float32_t * ptr, float32x4_t val);
    //将向量元素保存为连续4个单精度浮点数数
15
16
    //move
17
    int32x2_t vget_high_s32(int32x4_t a); //将a高位的两个元素复制到另一个向量寄存器
    float32x2_t vget_low_f32(float32x4_t a); //将a低位的两个元素复制到另一个向量寄存器
19
20
    float32_t vget_lane_f32(float32x2_t v, const int lane); //获得向量v第lane个通道的元素
21
    float32_t vgetq_lane_f32(float32x4_t v, const int lane); //获得向量v第lane个通道的元素
    | float32x2_t vset_lane_f32(float32_t a, float32x2_t v, const int lane); //设置向量v第lane个通道的元
23
   | float32x4_t vsetq_lane_f32(float32_t a, float32x4_t v, const int lane); ///设置向量v第lane个通道的
         元素的值为a
24
```

一个简单的例子:

```
1
    float sum(float* array, int n)
 2
 3
      float sum=0;
 4
      for (int k = 0; k < n; k++)
 5
      {
       sum+=array[k];
 7
      }
 8
 9
     return sum;
10
11
12
    float sum_neon(float* array,int n)
13
                                    // 假设n为4的倍数
14
      assert (n\%4==0);
      // 声明一个包含4个单精度浮点数的向量变量,用0初始化
15
16
      float32x4_t sum4=vmovq_n_f32(0);
17
      for(int i=0;i< n;i+=4){
18
       // 从(array+i)地址加载连续4个32位整数,保存到temp向量
19
       float32 \times 4\_t \ temp = vld1q\_f32(array + i);
20
       // sum4与temp向量对位相加
       sum4=vaddq_f32(sum4,temp);
21
22
23
      // 将低位两个元素保存到suml2向量
24
      float32x2_t suml2=vget_low_f32(sum4);
25
      // 将高位两个元素保存到sumh2向量
      float 32 \times 2\_t \ sumh 2 = vget\_high\_f 32 (sum 4);
26
27
      // 向量进行水平加法,得到suml2中两元素的和以及sumh2中两元素的和
      suml2 = vpadd_f32(suml2,sumh2);\\
28
      // 再次进行水平加法, 得到sum4向量4个元素的和
29
30
      float32_t sum=vpadds_f32(suml2);
      return (float)sum;
31
32
```

详细完整的 NEON Intrinsic 函数说明可以查询 ARM 官网文档 (点击超链接): Intrinsics -Arm Developer

2.1.4 SSE/AVX 的 C/C++ 编程

SSE 指令对应了 C/C++ 的 intrinsics(编译器能识别的函数,直接映射为一个或多个汇编语言指令)。使用 SSE intrinsics 所需的头文件:

```
#include <xmmintrin.h> //SSE

#include <emmintrin.h> //SSE2

#include <pmmintrin.h> //SSE3

#include <tmmintrin.h> //SSSE3

#include <smmintrin.h> //SSSE4.1

#include <nmmintrin.h> //SSSE4.2

#include <immintrin.h> //AVX、AVX2
```

编译选项: -march=corei7、-march=corei7-avx、-march=native
—些常用的指令:

```
1
       //数据类型
     __m128//float
 2
 3
    ___m128d// double
 4
    ___m128i//integer
   //load:
 5
    _mm_load_ps(float *p) //将从内存中地址p开始的4个float数据加载到寄存器中,要求p的地址是16字
 7
    _mm_loadu_ps(float *p)//类似_mm_load_ps但是不要求地址是16字节对齐
    //set:
 9
    _mm_set_ps(float a,float b,float c,float d) //将a,b,c,d赋值给寄存器
10
    //store:
    _mm_store_ps(float *p, _m128 a) //将寄存器a的值存储到内存p中
11
   //数据计算
    _mm_add_ps //加法
13
14
    _mm_mul_ps //乘法
    _mm_sub_ps //减法
15
16
    _mm_div_ps //除法
```

AVX 的各个指令与 SSE 类似,如 _mm_loadu_ps 的 AVX 版本为 _mm256_loadu_ps。

一个简单的例子:

```
1 \\串行加法:
2 void add()
3 {
for (int k = 0; k < N; k++)
5 {
matrix[k] += 2;
7 }
8 }
```

```
\\SSE优化
    void add()
10
11
12
         _m128 t1, t2;
13
       t1 = _mm_set1_ps(2); //t1中4个单精度浮点数设为2
14
       for (int k = 0; k < N; k += 4)
15
          // 从(matrix+k)读取连续的4个单精度浮点数
16
17
        t2 = _mm_loadu_ps(matrix+k);
        // 两个向量的4个单精度浮点数对位相加
18
        t2 = _mm_add_ps(t1, t2);
19
20
        // 将向量t2, 保存在地址(matrix+k)处
21
         _mm_store_ps(matrix+k, t2);
22
23
```

可参考此例以及课程讲义中矩阵乘法的例子对 LU 中的关键循环进行向量化。更多 SSE/AVX 指令,以及 AVX 的编程大家可以参考课程讲义。

所有 SSE/AVX 指令的细节可以查询官网文档 (点击超链接): Intel® IntrinsicsGuide

3 程序编译及运行

环境搭建和工具使用参考"实验环境搭建"指导书,ARM 平台实验使用我们的华为鲲鹏集群环境完成,x86 的实验可使用个人的笔记本电脑/台式机完成,AVX-512 的实验使用 Intel DevCloud 环境完成(为保持一致,SSE/AVX/AVX-512 的实验可均在此平台完成)。另外,鼓励大家测试多组数据和多种不同的优化算法进行对比,实验指导中所有结果仅供参考。

在鲲鹏服务器上编译的例子。

```
// gcc 编译器
gcc -g -march=native add.c -o add // c语言
g++ -g -march=native add.cpp -o add // c++
// 毕升编译器 (clang)
clang -g -march=armv8-a add.c -o add // c语言
clang++ -g -march=armv8-a add.cpp -o add // c++
```

这里补充一个 linux 下高精度时间测量的例子。

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>
```

```
4     struct timespec sts, ets;
5     timespec_get(&sts, TIME_UTC);
6     // to measure
7     timespec_get(&ets, TIME_UTC);
8     time_t dsec=ets.tv_sec-sts.tv_sec;
9     long dnsec=ets.tv_nsec-sts.tv_nsec;
printf("%llu.%09llus\n",dsec,dnsec);
```

4 使用 VTune 等工具剖析程序性能

类似之前的实验,实际上 NEON、SSE/AVX 优化与一般串行,对齐与不对齐等策略最终所执行的指令数,周期数,CPI 是不一样的,我们可以使用 per、VTune 等 profiling 工具分析对比。具体使用方法参考体系结构相关及性能测试实验指导书。